

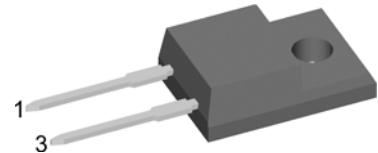
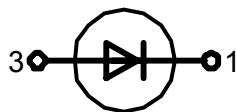
**Sonic-FRD**

High Performance Fast Recovery Diode  
Low Loss and Soft Recovery  
Single Diode

$V_{RRM} = 600 \text{ V}$   
 $I_{FAV} = 10 \text{ A}$   
 $t_{rr} = 35 \text{ ns}$

Part number (Marking on product)

DHG 10 I 600PM

**Features / Advantages:**

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low  $I_{rm}$ -values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low  $I_{rm}$  reduces:
  - Power dissipation within the diode
  - Turn-on loss in the commuting switch

**Applications:**

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

**Package:**

- TO-220FPAB
- Industry standard outline
  - Plastic overmolded tab for electrical isolation
  - Epoxy meets UL 94V-0
  - RoHS compliant

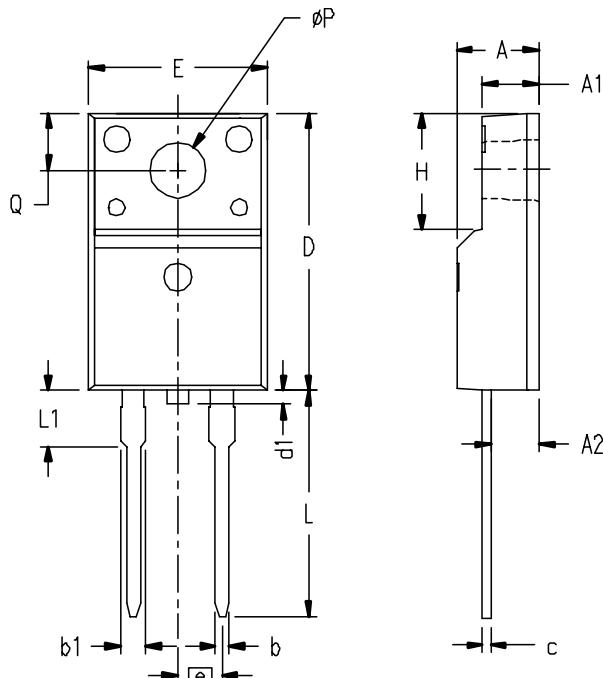
Ratings							
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
$V_{RRM}$	max. repetitive reverse voltage		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$			600	V
$I_R$	reverse current	$V_R = 600 \text{ V}$ $V_R = 600 \text{ V}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$			15	$\mu\text{A}$
$V_F$	forward voltage	$I_F = 10 \text{ A}$ $I_F = 20 \text{ A}$ $I_F = 10 \text{ A}$ $I_F = 20 \text{ A}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$  $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$			2.35	V
$I_{FAV}$	average forward current	rectangular, $d = 0.5$	$T_C = 30^\circ\text{C}$			10	A
$V_{FO}$ $r_F$	threshold voltage slope resistance	for power loss calculation only	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$			1.20	V
						93	$\text{m}\Omega$
$R_{thJC}$	thermal resistance junction to case					4.00	K/W
$T_{VJ}$	virtual junction temperature			-55		150	$^\circ\text{C}$
$P_{tot}$	total power dissipation		$T_C = 25^\circ\text{C}$			31	W
$I_{FSM}$	max. forward surge current	$t_p = 10 \text{ ms (50 Hz), sine}$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$			100	A
$I_{RM}$	max. reverse recovery current	$I_F = 10 \text{ A};$ $-di_F/dt = \text{A}/\mu\text{s}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		4		A
$t_{rr}$	reverse recovery time	$V_R = 200 \text{ V}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		35		ns
$C_J$	junction capacitance	$V_R = 300 \text{ V}; f = 1 \text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$				pF
$E_{AS}$	non-repetitive avalanche energy	$I_{AS} = \text{A}; L = 100 \mu\text{H}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$			tbd	mJ
$I_{AR}$	repetitive avalanche current	$V_A = 1.5 \cdot V_R \text{ typ.; } f = 10 \text{ kHz}$				tbd	A

Symbol	Definition	Conditions	Ratings			
			min.	typ.	max.	
$I_{RMS}$	RMS current	per pin*			35	A
$R_{thCH}$	thermal resistance case to heatsink			0.50		K/W
$M_D$	mounting torque		0.4		0.6	Nm
$F_c$	mounting force with clip		20		60	N
$T_{stg}$	storage temperature		-55		150	°C
Weight				2		g

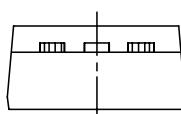
\*  $I_{RMS}$  is typically limited by: 1. pin-to-chip resistance; or by 2. current capability of the chip.

In case of 1, a common cathode/anode configuration and a non-isolated backside, the whole current capability can be used by connecting the backside.

### Outlines TO-220FPAB



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.177	.193	4.50	4.90
A1	.092	.108	2.34	2.74
A2	.101	.117	2.56	2.96
b	.028	.035	0.70	0.90
b1	.050	.058	1.27	1.47
c	.018	.024	0.45	0.60
D	.617	.633	15.67	16.07
d1	0	.043	0	1.10
E	.392	.408	9.96	10.36
e	.100 BSC		2.54 BSC	
H	.255	.271	6.48	6.88
L	.499	.523	12.68	13.28
L1	.119	.135	3.03	3.43
$\emptyset P$	.121	.129	3.08	3.28
Q	.126	.134	3.20	3.40



#### NOTE:

- All metal surface are matte pure tin plated except trimmed area.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,  
помещение 100-Н Офис 331